

Неделя №12

Низкоразмерные электронные системы

Драчев Ярослав
Факультет общей и прикладной физики МФТИ

9 мая 2021 г.

4.48.

Решение. Расстояние между уровнями энергии в яме с бесконечными стенками с шириной, равной толщине плёнки $\Delta E = \frac{3\hbar^2\pi^2}{2md^2}$. Рассеяние для продольного движения приведёт к уширению уровней на величину порядка

$$\frac{\hbar}{\tau} = \hbar \frac{V_F}{l},$$

где τ — время пробега, а l — длина пробега (это соотношение неопределённости для энергии). Для оценки приравниваем эти выражения

$$\Delta E \simeq \hbar \frac{V_F}{l} \frac{\hbar}{l} \sqrt{\frac{2E_F}{m}}.$$

$$l \simeq \frac{2md^2}{3\hbar\pi^2} \sqrt{\frac{2E_F}{m}} = 5,8 \cdot 10^{-6} \text{ см.}$$

4.30.

Решение.

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

$$R_{sq} = \rho \frac{L}{Ld} = \frac{1}{\sigma d} = \frac{m}{dne^2\tau} = \frac{m}{n_se^2\tau},$$

где n_s — поверхностная плотность.

$$R_{sq} = \frac{mV_F}{n_se^2l} = \frac{p_F}{n_se^2l} = \frac{\sqrt{2\pi n_s}\hbar}{n_se^2l}.$$

Если длина пробега равна межатомному расстоянию и 1 электрон на атом, то $l = a$ и $n_s = 1/a^2$ в результате параметр решётки сокращается и

$$R_{sq} = \frac{\hbar}{e^2} \sqrt{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\hbar}{e^2} \approx 10,3 \text{ кОм.}$$

T12-3.

Решение. Переменное поле заставляет электроны колебаться, при этом переменная деформация поверхности излучает риплоны. Резонанс возникает, если риплоны излучённые разными центрами будут генерироваться в фазе. Это означает, что на характерном межэлектронном расстоянии должна укладываться длина волны риплона, для оценки деталями устройства решётки не интересуемся. Т. е. задача становится эквивалентна двумерной решётке излучателей.

Если a — характерное расстояние, то условие резонанса (оценочно)

$$n \simeq \frac{1}{a^2} \simeq \frac{k^2}{(2\pi)^2} = \frac{1}{(2\pi)^2} \left(\frac{\rho\omega^2}{\sigma} \right)^{\frac{2}{3}} \simeq 1,5 \cdot 10^9 \text{ 1/см}^2.$$

T12-4.

Решение. Для GaAs циклотронное расщепление 1,72 мэВ/Тл, зеемановское расщепление $0,44 \cdot 0,06$ мэВ/Тл, т. е. примерно 0,03 мэВ/Тл (в 57 раз меньше циклотронного).

Вообще говоря, оба упомянутых расщепления уровней энергии (циклотронное $\hbar\omega_c$ и спиновое $g\mu_B B$) пропорциональны магнитному полю, поэтому не сравниваются никогда. Однако, ситуация равных расщеплений (и соответствующей перестройки систематики уровней энергии) возможна в наклонных магнитных полях, т. к. зеемановское расщепление определяется полным полем, а циклотронное — лишь компонентой, перпендикулярной плоскости образца.

Таким образом, сравниваются эти расщепления при наклоне поля по отношению к нормали к образцу на угол $\arccos(1/57)$, т. е. 89 градусов.

T12-5.

Решение. У уровней Ландау есть конечное вырождение. Оно может быть оценено из тех соображений, что магнитная длина $l = \sqrt{\frac{\hbar c}{2\pi e B}}$ задаёт среднее расстояние между электронами в магнитном поле, т. е. на один электрон приходится площадь $\sim l^2$ (точное значение $2\pi l^2$).

Соответственно, вырождение уровня Ландау есть обратная величина $N_L = \frac{1}{2\pi l^2} = \frac{eB}{\hbar c}$, в числах: $(2,418 \cdot 10^{10} B) \text{ 1/см}^2$ (поле B — в теслах).

Осталось определить фактор заполнения. Поскольку холловское сопротивление квантуется с квантом 25812 Ом, то значение 12,9 кОм соответствует фактору заполнения $n = 2$. Значит, если заполнено 2 уровня Ландау в поле 10 Тл, а число электронов на одном уровне на единицу площади есть $2,418 \cdot 10^{11} \text{ 1/см}^2$ то полная концентрация N_s электронов в образце есть $4,8 \cdot 10^{11} \text{ 1/см}^2$.

T12-6.

Решение. В обычном проводнике расстояние между уровнями Ландау задаётся циклотронной частотой $E = \hbar\omega_c(n + 1/2)$, где циклотронная частота $\omega_c = \frac{|e|\hbar B}{mc}$ зависит от эффективной массы. В графене спектр электронов релятивистский — эффективная масса равна нулю.

Характерный масштаб можно найти пользуясь соображениями размерности. Характерная частота должна зависеть от:

1. Параметров спектра, т. е. скорости Ферми c^*
2. Магнитного поля, которое во все уравнения входит как B/c

3. Заряда электрона $|e|$

4. Постоянной Планка \hbar

Стандартно подбирая степени получаем

$$\omega_c \sim \sqrt{\frac{eB}{\hbar c}} c^*.$$

Это задаёт масштаб энергии

$$\Delta E = \hbar \omega_c \sim \sqrt{\frac{\hbar e B}{c}} c^* \simeq 1000 \text{ K}.$$